

<b>Таблица 1. Масштабирование МОП-транзисторов согласно NTRS [28]</b>						
Проектные нормы, нм	250	180	130	100	70	
Толщина окисла, нм	4–5	3–4	2–3	1,5–2	<1,5	
Глубина <i>p-n</i> -переходов, нм	50–100	36–72	26–52	20–40	15–30	
Напряжение питания, В	1,8–2,5	1,5–1,8	1,2–1,5	0,9–1,2	0,6–0,9	
Ток утечки, нА/мкм	1	1	3	3	10	
Нагруз. способн., мА/мкм	600/280	600/280	600/280	600/280	600/280	
Мощность/кристалл, Вт	70	93	121	120	114	